【裁判字號】96,訴,1314
【裁判日期】970306
【裁判案由】發明專利異議
【裁判全文】
臺北高等行政法院判決

96年度訴字第01314號

.

原　　告　友達光電股份有限公司
代　表　人　甲○○
訴訟代理人　丙○○
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）住同上
訴訟代理人　丁○○
參　加　人　乙○○

上列當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國96年2月15日經訴字第09606062470號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟。本院判決如下：

主　文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事　實

一、事實概要：

緣原告前於民國（下同）91年9月5日以「一種有機發光二極體」向被告機關智慧財產局申請發明專利（下稱系爭專利），經被告編爲第00000000號審查，於92年9 月1 日審定准予專利。公告期間，參加人乙○○（下稱參加人）以其違反核准審定時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項之規定，不符發明專利要件，對之提起異議。案經被告機關審查，於95年8 月15日以

(95) 智專三(二)04066字第09520649250 號專利異議審定書爲「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

(一)原告聲明求爲判決：

1.關於原告第000000000號「一種有機發光二極體」專利案之被告95年8月15日〈95〉智專三（二）04066字第09520649250號處分以及經濟部訴願決定應予以撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

(二)被告聲明求爲判決：

1.原告之訴駁回。

2.訴訟費用由原告負擔。

(三)參加人未到庭或以書狀提出意見或陳述。

三、兩造之爭點：系爭處分有無事實與理由矛盾之違法情事及系爭專利是否有違反核准審定時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項之規定？

(一)原告主張之理由：

1.原告認爲被告對於系爭專利申請專利範圍第1、11、12、14、24及25項之上述處分理由，不符合被告之「專利審查基準」與專利法精神，其理由說明如下；

(1)根據「專利審查基準」(民國八十九年十月再版版本，第1-2-19頁及第1-2-20頁，證物三)之規定：判斷進步性之基本原則乃爲「判斷進步性之前，須先判斷該發明是否具備新穎性要件，經判斷該發明具有新穎性後，始能判斷有無進步性」「…"有無進步性"之問題，僅於有新穎性之情況下，始會產生」。原告在原處分針對系爭專利申請專利範圍第1項是否有新穎性之判定時（前列之原處分審定理由（一）），僅將系爭專利申請專利範圍第1項之上述第（Ａ）、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及（ｄ）點限制條件與證據２所揭露之上述第（３）、（４）、（５）點內容做比對，指出兩者特徵不同，因此系爭專利申請專利範圍第1項具有新穎性。由此可知，被告僅就系爭專利申請專利範圍第1項之上述第（Ａ）、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及（ｄ）點特徵進行有無新穎性之判斷。然而，被告從未在原處分中確認系爭專利申請專利範圍第1項之上述第（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）點特徵是否具有新穎性，即針對系爭專利申請專利範圍第1項之該第（Ｄ）點進行進步性之比對（前列原處分理由（二）），並認爲證據２之第（５）點內容能使熟悉該項技術者輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項第（Ｄ）點之內容。相反的，若依據「專利審查基準」的規定，被告應該係針對已確認具有新穎性之系爭專利申請專利範圍第1項之上述第（Ａ）、（ａ）（ｂ）（ｃ）及（ｄ）點與證據２進行比對，以進行進步性之判斷，而非直接判斷尚未確定是否有新穎性之上述第（Ｄ）點內容的進步性問題。因此，被告在未確定系爭專利申請專利範圍第1項之第（Ｄ）點特徵具有新穎性之情況下，逕行審定該第（Ｄ）點特徵不具有進步性，明顯不符被告「專利審查基準」之規定。

(2)同樣地，原告在原處分針對系爭專利申請專利範圍第14項是否有新穎性之判定時（前列之原處分理由（四）），僅將系爭專利申請專利範圍第14項之上述第（Ｆ）、（ｇ）、（ｈ）、（ｉ）、（Ｋ）點限制條件與證據２所揭露之上述第（９）、（１０）、（１１）點內容做比對，指出兩者特徵不同，因此認定系爭專利申請專利範圍第14項具有新穎性。另，被告在有關系爭專利申請專利範圍第14項是否有進步性之判斷時（前列之原處分理由（五）），係指出系爭專利申請專利範圍第14項之上述第（Ｆ）至（Ｌ）點特徵，可由證據２之上述第（１１）點特徵所揭示結構所能輕易完成，而判定系爭專利申請專利範圍第14項上述第（Ｆ）至（Ｌ）點不具進步性，因此審定系爭專利申請專利範圍第14項不具進步性。由上述可知，被告僅就系爭專利申請專利範圍第14項之上述第（Ｆ）、（ｇ）、（ｈ）、（ｉ）、（Ｋ）點特徵進行有無新穎性之判斷，卻從未確認系爭專利申請專利範圍第14項之其他特徵（例如上述第（Ｇ）至（Ｊ）、（Ｌ）點）是否具有新穎性之情況下，逕行審定該第（Ｆ）至（Ｌ）點不具進步性。根據「專利審查基準」之規定：判斷進步性之基本原則乃爲「判斷進步性之前，須先判斷該發明是否具備新穎性要件，經判斷該發明具有新穎性後，始能判斷有無進步性」「…"有無進步性"之問題，僅於有新穎性之情況下，始會產生。」被告既從未確定系爭專利申請專利範圍第14項之第（Ｇ）至（Ｊ）及（Ｌ）點特徵具有新穎性，即進行審定上述特徵沒有進步性之審定，明顯不符被告「專利審查基準」之規定。

(3)根據被告「專利審查基準」第二章第四節(二)之判斷進步性之基本原則（第1-2-19頁），明載：「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性。」。另外，「專利審查基準」第二章第四節(五)亦明載（第1-2-27頁，證物四）：「１.進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。２.獨立項之發明具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。且不得因獨立項之發明不具有進步性，而對其附屬項與逕予核駁，因其附屬項仍須

依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。…６.進步性之研判，因審查委員在審查中瞭解其技術內容後，極易對發明之進步性作成偏低之評斷，以致有"後見之明"之情形，故審查時應以熟習該項技術者之觀點，根據申請當時之技術水準，作客觀之判斷。」原告認為上述審查基準確實符合專利法第20條第2項之規定及立法意旨，因此，依據上述審查基準，被告應對系爭專利申請專利範圍第1至27項的所有技術特徵與證據２及異議申請書中所提其他引證案（下稱證據３與證據４）逐一做詳實之比對，以瞭解系爭專利申請專利範圍是否與引證案有所不同，若有，便為具有新穎性，則原審查委員應將所有引證案之全部或部分技術特徵並加以組合，並將組合的結果與系爭專利申請專利範圍之全部技術特徵進行比對，以瞭解系爭專利每一申請專利範圍是否具有進步性，以證明：（１）藉由組合所有引證案之技術特徵，可以完成系爭專利申請專利範圍之全部技術特徵，以及（２）該選擇與組合不具有困難度，是熟習該項技術者所能輕易完成者。若無法合理或輕易的組合，或是系爭專利較引證案之組合所無法預期的功效，則該項申請專利範圍即具有進步性，應准予專利。然而，被告在針對系爭專利申請專利範圍第11、12、24、25項進行審核時，原告未見被告就上述申請專利範圍的所有技術特徵與引證案做詳實比對，亦未見證據２至４的技術內容可以合理組合而得到系爭專利申請專利範圍第11、12、24、25項的所有技術內容，被告機關僅以「所載技術特徵可為熟悉該項技術者可藉由證據２之結構揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭專利申請專利範圍具有進步性」之主觀意識來認定系爭專利申請專利範圍第11、12、24、25項不具進步性，實與上述「專利審查基準」第二章第四節(五)「審查上應注意事項」所規定者不符。據此，原告主張原處分實有不當之處。

(4)被告在訴願答辯書中提出答辯理由：「證據２至４與系爭案有相同創作目的，已揭露系爭專利所有構件，有相同技術手段，亦同樣具有功效，審定書已詳載證據２至４足資證明系爭專利不具進步性之理由，不再贅述，原處分認事用法並無違誤」以及「系爭專利附屬項11、12、24 、25雖為獨立項之進一步限制，惟僅在於界定溝槽深度等技術特徵，可為熟悉該項技術者藉由證據２至４所揭示輕易完成，故不具進步性。」然而，被告之答

辯理由卻與事實不符。系爭專利申請專利範圍第11、24項敘述：「有機發光二極體另包含有至少一第二溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該下基板中…」，而系爭專利申請專利範圍第12、25項敘述：「有機發光二極體另包含有至少一第三溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該透明導電層中…」等技術內容。經與引證案比對，引證案從未教導、揭露或暗示系爭專利申請專利範圍第11、12、24、25項之上述技術內容。雖然審查委員認爲上述技術內容爲熟悉該項技術者可藉由證據２之結構揭示所能思及而輕易完成者，然而引證案中從未教導或暗示在下基板或下基板表面之陽極上形成一至二個溝槽，以有效避免密封材料（例如封膠）在下基板溢流而污染設於下基板上的有機發光元件。亦即證據２及其他引證案無法考量到封膠於下基板表面產生形變時，如何防止封膠溢流至下基板表面的有機發光元件。由證據２第4A至4D以及第7A至7B圖可知，框膠212直接設置在下基板200表面的有機發光元件202鄰側，所以將蓋板（上基板）204組裝至下基板200上時，若有多餘之框膠212，則框膠212會產生形變，顯然會直接溢流至鄰側有機發光元件202上方，嚴重影響發光效率。再參照證據２第7C至7D圖，雖然框膠212沒有直接設置在有機發光元件202鄰側，但在組裝蓋板204時，多餘的框膠212仍會直接在原點膠處兩側的下基板200表面溢流，接觸下基板200表面的有機發光元件202，造成污染。所以證據２從未教導如何解決在下基板200表面溢流之框膠212的問題。再者，由於在下基板200上方的有機發光元件202即爲有機發光顯示器最重要的裝置，因此證據２顯然沒有提供避免有機發光元件202被框膠212污染的實質方法以及保護有機發光元件202的有效設計，而只教導了避免框膠212溢流在蓋板204表面之方法。反觀系爭專利請求項11、12與24、25項，其教導了直接在設置有機發光元件的下基板上設置一至多個溝槽，可以有效避免封裝材料污染下基板上的重要元件，提供了以往封裝材料污染有機發光元件的完整解決方法，亦是證據２及其他引證案所無法提供之功能。根據中華民國專利審查基準第三章有關進步性之敘述（第1-2-21頁，證物五）：「組合二件或二件以上之文獻內容後，與申請專利發明之必要的技術內容，在本質上無法相切合時，則此等文獻之組合，通常識爲非能輕易完成。」「以先前技術之片斷部

分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有『突出的技術特徵』或『顯然的進步』。…『顯然的進步』係指申請申請專利之發明克服先前技術中存在的問題或困難性而言，通常係表現於功效上。例１：在技術發展空間有限之領域中，如在技術上有微小的改進，得視爲具有『顯然的進步』。」由上述可知，即使被告認爲本案請求項11、12、24、25項爲證據２之簡單轉用與置換，但系爭專利申請專利範圍第11、12、24、25項所提供之結構能夠確保框膠直接與主動區域內的有機發光元件相接觸，影響有機發光元件的發光品質，較先前技術具有無法預期之明顯進步功效，所以，被告針對本案請求項11、12、24、25之原處分不符合上述專利審查基準及專利法第20條第2項之規定。

2.原處分認定事實有誤：

(1)申請專利範圍第12項：

系爭案之申請專利範圍第12項爲：「12.如申請專利範圍第1項之有機發光二極體另包含有至少一第三溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該透明導電層中，且該第三溝槽之深度係小於該透明導電層之厚度。」原處分理由（六）：「系爭案附屬項第12項該第三溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該下基板中，且該第三溝槽之深度係小於該下基板之厚度」（原處分第6頁第34至36行參照），與前揭申請專利範圍記載不符，其認定事實顯然有誤。認定事實爲適用法律之基礎。原處分審查申請專利範圍第12項不具進步性之事實基礎既有錯誤，自無以維持。訴願決定照抄原處分內容（訴願決定第5頁第23至24行參照），其錯誤同出一轍，亦無可維持。

(2)申請專利範圍第20項：

系爭案之申請專利範圍第20項爲：「20.如申請專利範圍第19項之有機發光元件另包含有複數層電洞注入層(hole injection layer, HIL)，且各該電洞注入層係分別位於各該下電極與各該電洞傳輸層之間。」原處分理由（八）：「系爭案附屬項第20項另包含有一電洞注入層(hole injection layer，HIL)位於該下電極與該電洞傳輸層之間」（原處分第9頁第29至31行參照），與前揭申請專利範圍記載不符，其認定事實顯然有誤。認定事實爲適用法律之基礎。原處分審查申請專利範圍第20項不具進步性之事實基礎既有錯誤，自無以維持。訴願決定照抄原處分內容（訴願決定第7頁第6至7行參

照），其錯誤同出一轍，亦無可維持。

(3)申請專利範圍第21項：

系爭案之申請專利範圍第21項爲：「21.如申請專利範圍第19項之有機發光元件另包含有複數層電子注入層(electron injection layer, EIL)，且各該電子注入層係分別位於各該電子傳輸層與各該上電極之間。」原處分理由（八）記載：「系爭案附屬項第21項另包含有一電子注入層(electron injection layer，EIL)位於該電子傳輸層與該上電極之間」（原處分第9頁第38行至第10頁第1行參照），與前揭申請專利範圍記載不符，其認定事實顯然有誤。認定事實爲適用法律之基礎。原處分審查申請專利範圍第21項不具進步性之事實基礎既有錯誤，自無以維持。訴願決定照抄原處分內容（訴願決定第7頁第8至9行參照），其錯誤同出一轍，亦無可維持。

(4)申請專利範圍第24項：

系爭案之申請專利範圍第24項爲：「24.如申請專利範圍第14項之有機發光元件另包含有至少一第二溝槽位於該點膠區域與該主動區域間的該下基板中，且該第二溝槽之深度係小於該下基板之厚度。」原處分理由（八）：「系爭案附屬項第24項該第二溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該下基板中，且該第二溝槽之深度係小於該下基板之厚度」（原處分第10頁第20至21行參照），與前揭申請專利範圍記載不符，其認定事實顯然有誤。認定事實爲適用法律之基礎。原處分審查申請專利範圍第24項不具進步性之事實基礎既有錯誤，自無以維持。訴願決定照抄原處分內容（訴願決定第7頁第21至22行參照），其錯誤同出一轍，亦無可維持。

(5)申請專利範圍第25項：

系爭案之申請專利範圍第25項爲：「25.如申請專利範圍第14項之有機發光元件另包含有至少一第三溝槽位於該點膠區域與該主動區域間的該透明導電層中，且該第三溝槽之深度係小於該透明導電層之厚度。」原處分理由（八）：「系爭案附屬項第25項該第三溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該下基板中，且該第三溝槽之深度係小於該下基板之厚度」（原處分第10頁第27至28行參照），與前揭申請專利範圍記載不符，其認定事實顯然有誤。認定事實爲適用法律之基礎。原處分審查申請專利範圍第25項不具進步性之事實基礎既有錯誤，自

無以維持。訴願決定照抄原處分內容（訴願決定第7頁第23至24行參照），其錯誤同出一轍，亦無可維持。

(6)原處分之錯誤已不得補正：

行政程序法第114條第1項規定行政處分瑕疵之補正，同條第2項規定：「前項第二款至第五款之補正行爲，僅得於訴願程序終結前爲之；得不經訴願程序者，僅得於向行政法院起訴前爲之。」大院91年訴字第3368號判決指出：「按理由不備（違反程序或方式規定）之行政處分，依行政程序法第一百十四條第一項第二款，固得於事後記明理由而補正之，但依同法條第二項規定，此補正僅得於訴願程序終結前爲之。」（附件一），原處分之前述錯誤既已逾行政程序法第114條第2項規定補正期間而不得補正，自無可維持。

原處分認定事實有誤：

補充起訴理由書第2至6頁已詳述原處分審查系爭案之申請專利範圍第12、20、21、24、25項，認定事實有誤。被告於96年1月8日第一次準備程序已承認原處分確有錯誤。

訴願決定及原處分均構成理由不備之違法：

行政程序法第43條規定：「行政機關爲處分或其他行政行爲，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真僞，並將其決定及理由告知當事人。」行政程序法第96條第1項規定：「行政處分以書面爲之者，應記載下列事項：・・・二主旨、事實、理由及其法令依據。・・・」是知屬於行政處分之異議審定書應記載「理由」，理由係指記載完整且正確之理由而言，否則即因未符上揭法律規定而生理由不備之違法。前述認定事實錯誤，嚴重影響原處分所附理由之完整性與正確性。以申請專利範圍第25項爲例，系爭案之申請專利範圍第25項爲：「25.如申請專利範圍第14項之有機發光元件另包含有至少一第三溝槽位於該點膠區域與該主動區域間的該透明導電層中，且該第三溝槽之深度係小於該透明導電層之厚度。」；原處分理由（八）記載：「系爭案附屬項第25項該第三溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該下基板中，且該第三溝槽之深度係小於該下基板之厚度」（原處分第10頁第27至28行參照），既將「主動區域」誤爲「預定區域」，又將「透明導電層」誤爲「下基板」，在短短三行中即有三處明顯錯

誤，而「主動區域」與「預定區域」、「透明導電層」與「下基板」在系爭案均爲不同位置或元件，可知原處分根本未針對申請專利範圍第25項之技術內容進行審查，認定本項不符專利要件，即屬理由不備之違法。

(7)訴願決定及原處分均應撤銷：

被告所公布「專利審查基準」規定：「判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載發明，判斷有無專利法第二十條第二項之規定情事，如有則不具進步性，如無始具有進步性。」（1-2-20頁參照）被告審查前揭申請專利範圍第12、20、21、24、25項，認定事實有誤，未依申請專利範圍之請求項所載發明判斷有無進步性，原處分之認事用法自有違誤，無以維持。訴願機關受理原告所提訴願，應審查原處分是否違法或不當。訴願決定照抄原處分內容，認定事實錯誤與原處分同出一轍，亦無可維持。行政訴訟法第1條揭櫫「保障人民權益，確保國家行政權之合法行使，增進司法功能」之立法宗旨。原處分之前述錯誤既已逾行政程序法第114條第2項規定補正期間而不得補正，敬請大院撤銷訴願決定及原處分，以保障人民權益，並確保行政處分之合法性。

3.原處分違反90年專利法第20條第2項規定：

(1)申請專利範圍第1項：

系爭案之申請專利範圍第1項爲：「1.一種有機發光二極體(organic light emitting diode, OLED)，該有機發光二極體包含有：一下基板，該下基板包含有一下電極設於該下基板表面，一有機薄膜設於該下電極之一預定區域表面，一上電極設於該有機薄膜表面，以及一點膠(spot glue)區域設於該預定區域外之該下基板表面；一上基板，平行於該下基板，且該上基板相對於該下基板之該點膠區域與該預定區域間的表面包含有至少一第一溝槽(ditch)；以及一密封材料(sealing material)，位於該下基板之該點膠(spot glue)區域上，用來黏結該上基板與該下基板；其中該第一溝槽係用來避免該密封材料溢入該下基板之該預定區域中而影響該有機發光二極體之正常操作。」前揭系爭案之申請專利範圍第1項對應於第一實施例即附件A圖1。

異議證據2之第一實施例對應於附件A圖2之第4A圖，第二實施例對應於附件A圖2之第7A圖。

證據2未揭露或教示系爭案之「上電極」「下電極」

技術特徵：

系爭案之「上電極」設於有機薄膜表面，「下電極」設於下基板表面，證據2無論發明說明或圖式均未揭露或教示系爭案之「上電極」「下電極」技術特徵。

證據2未揭露或教示系爭案之「第一溝槽」技術特徵：

系爭案之第一溝槽設置於上基板相對於下基板之「點膠區域與預定區域間」的表面，避免溢膠「向內流」，達成效果是「避免該密封材料溢入該下基板之該預定區域中而影響該有機發光二極體之正常操作」（系爭案之申請專利範圍第1項）。證據2之溝渠（206）設置於蓋板（204）的「邊緣」，避免溢膠「向外流」，第4A圖之溝渠（206）設置於框膠（212）外緣，第7A圖之溝槽（206）設置於框膠（212）外緣與有機電激發光顯示器元件（202）上方，達成效果是「框膠212的分佈不會超出溝渠206而造成溢膠的現象，進而造成後續模組裂片的困難」（證據2之說明書第10頁）。系爭案之第一溝槽與證據2之溝渠的技術手段、達成效果均不同。證據2未揭露或教示系爭案之「第一溝槽」技術特徵。

申請專利範圍第1項具有進步性：

證據2未揭露或教示系爭案之「上電極」「下電極」「第一溝槽」技術特徵。熟習該項技術者由證據2無法輕易完成本項發明內容。因此，申請專利範圍第1項具有進步性。依據「專利審查基準」規定：「獨立項之發明具進步性時，其附屬項當然具進步性」（1-2-27頁）。系爭案之申請專利範圍第2至13項直接或間接依附於第1項，包含第1項的所有技術特徵並作進一步限定。申請專利範圍第1項具有進步性，第2至13項當然亦具有進步性。

原處分違反90年專利法第20條第2項規定：

原處分理由（六）謂：「查證據2所揭示蓋板上係具有溝渠，可使框膠的分佈不會超過溝渠，可避免溢膠的現象。相較系爭案申請專利範圍第1項所揭示之技術特徵該第一溝槽係用來避免該密封材料溢入該下基板之該預定區域中而影響該有機發光二極體之正常操作，熟悉該項技術者可藉由證據2所揭示之結構所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第1項具有進步性。」（原處分第4頁第30至37行參照）證據2

未揭露或教示系爭案之「上電極」「下電極」技術特徵。證據2之溝渠（206）係避免溢膠「向外流」而設置於蓋板的邊緣，而系爭案之「第一溝槽」係避免溢膠「向內流」而設置於「點膠區域與預定區域間」的上基板，二者之技術手段及達成效果均有顯著差異。原處分忽略系爭案與證據2之差異，認定系爭案申請專利範圍第1項不具進步性實屬率斷，違反90年專利法第20條第2項規定。

(2)申請專利範圍第11項：

系爭案之申請專利範圍第11項爲：「11.如申請專利範圍第1項之有機發光二極體另包含有至少一第二溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該下基板中，且該第二溝槽之深度係小於該下基板之厚度。」

證據2未揭露或教示系爭案之「第二溝槽」技術特徵：

系爭案之第二溝槽設置於位於「點膠區域與預定區域間」的「下基板」中，避免溢膠「向內流」，達成效果是「避免該密封材料溢入該下基板之該預定區域中而影響該有機發光二極體之正常操作」（系爭案之申請專利範圍第1項）。證據2之第4A圖與第7A圖的溝渠（206）均設置於「蓋板」（204）（對應於系爭案之「上基板」）的「邊緣」。系爭案之第二溝槽與證據2之溝渠的技術手段、達成效果均不同。證據2未揭露或教示系爭案之「第二溝槽」技術特徵。

申請專利範圍第11項具有進步性：

熟習該項技術者由證據2無法輕易完成本項發明內容。因此，申請專利範圍第11項具有進步性。

原處分違反90年專利法第20條第2項規定：

原處分理由（六）謂：「系爭案附屬項第11項該第二溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該下基板中，且該第二溝槽之深度係小於該下基板之厚度，惟此技術特徵可藉由證據2圖7A所揭示，內側的溝渠係位於點膠區域以及有機電激發光顯示器元件之間，即系爭案附屬項11所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由證據2之結構揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第11項具有進步性。」（原處分第6頁第27至34行參照）證據2之溝渠（206）係避免溢膠「向外流」設置於「蓋板」（204）（對應於系爭案之「上基板」）的「邊緣」，而系爭案之「第二溝槽」

係避免溢膠「向內流」設置於位於「點膠區域與預定區域間」的「下基板」中，一在上一在下，二者之技術手段及達成效果均有顯著差異。原處分忽略系爭案與證據2之差異，認定系爭案申請專利範圍第11項不具進步性實屬率斷，違反90年專利法第20條第2項規定。

(3)申請專利範圍第12項：

系爭案之申請專利範圍第12項為：「12.如申請專利範圍第1項之有機發光二極體另包含有至少一第三溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該透明導電層中，且該第三溝槽之深度係小於該透明導電層之厚度。」

證據2未揭露或教示系爭案之「第三溝槽」技術特徵：

系爭案之第三溝槽設置於位於「點膠區域與預定區域間」的「透明導電層」中，避免溢膠「向內流」，達成效果是「避免該密封材料溢入該下基板之該預定區域中而影響該有機發光二極體之正常操作」（系爭案之申請專利範圍第1項）。證據2之溝槽結構設置於「蓋板」（對應於系爭案之「上基板」）的「邊緣」，第4A圖之溝渠（206）設置於框膠（212）外緣，第7A圖之溝槽（206）設置於框膠（212）外緣與有機電激發光顯示器元件（202）上方，避免溢膠「向外流」，達成效果是「框膠212的分佈不會超出溝槽206而造成溢膠的現象，進而造成後續模組裂片的困難」（證據2之說明書第10頁）。系爭案之第三溝槽與證據2之溝槽結構的技術手段、達成效果均不同。證據2未揭露或教示系爭案之「第三溝槽」技術特徵。

申請專利範圍第12項具有進步性：

熟習該項技術者由證據2無法輕易完成本項發明內容。因此，申請專利範圍第12項具有進步性。

原處分違反90年專利法第20條第2項規定：

原處分理由（六）謂：「系爭案附屬項第12項該第三溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該下基板中，且該第三溝槽之深度係小於該下基板之厚度，惟此技術特徵可藉由證據2圖7A所揭示，內側的溝渠係位於點膠區域以及有機電激發光顯示器元件之間，即系爭案附屬項12所載技術特徵可為熟悉該項技術者可藉由證據2之結構揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第12項具有進步性。」（原處分第6頁

第34行至第7頁第1行參照）如前所述（一（一）），原處分將系爭案申請專利範圍第12項之第三溝槽位於點膠區域與該預定區域間的「透明導電層」中，誤爲「下基板」中，其認定事實有誤。證據2之溝渠（206）係避免溢膠「向外流」設置於「蓋板」（204）（對應於系爭案之「上基板」）的「邊緣」，而系爭案之「第三溝槽」係避免溢膠「向內流」設置於位於「點膠區域與預定區域間」的「透明導電層」中，一在上一在下，二者之技術手段及達成效果均有顯著差異。原處分忽略系爭案與證據2之差異，認定系爭案申請專利範圍第12項不具進步性實屬率斷，違反90年專利法第20條第2項規定。

(4)申請專利範圍第14項：

系爭案之申請專利範圍第14項爲：「14.一種有機發光元件，該有機發光元件係包含有至少二有機發光二極體(organic light emitting diode, OLED)，該有機發光元件包含有：一下基板，該下基板表面包含有至少二元件區域，至少一切割區域位於兩相鄰該元件區域之間，且各該元件區域均包含有一下電極設於該元件區域表面，一有機薄膜設於該元件區域之一主動區域上，以及一上電極設於該有機薄膜表面；一上基板，平行地設於該下基板之上，且該上基板相對於該下基板的表面包含有至少二第一區域相對應於該下基板之該等元件區域，至少一第二區域相對應於該下基板之該切割區域，以及複數個第一溝槽(ditch)分別位於該上基板之各該第一區域中；以及一密封材料(sealing material)位於該上基板與該下基板間之各該主動區域外之一點膠(spot glue)區域上，用來黏結該上基板與該下基板；其中該等第一溝槽係用來避免該密封材料溢出該下基板之該切割區域中與溢入該下基板之各該主動區域中，而影響各該有機發光二極體之正常操作。」前揭系爭案之申請專利範圍第14項對應於第二實施例即附件A圖3。

異議證據2之第一實施例對應於附件A圖4之第4A圖，第二實施例對應於附件A圖4之第7A圖。

證據2未揭露或教示系爭案之「至少二元件區域」「至少一切割區域」「至少二第一區域」「至少一第二區域」「上電極」「下電極」技術特徵：

系爭案之下基板表面包含有「至少二元件區域」，「至少一切割區域」位於兩相鄰該元件區域之間，且上

基板相對於下基板的表面包含有「至少二第一區域」相對應於下基板之元件區域，「至少一第二區域」相對應於下基板之切割區域。證據2爲單一有機發光二極體，無論發明說明或圖式均未揭露或教示系爭案之「至少二元件區域」「至少一切割區域位於兩相鄰該元件區域之間」「至少二第一區域相對應於該下基板之該等元件區域」「至少一第二區域相對應於該下基板之該切割區域」技術特徵。系爭專利之各該元件區域均包含有「上電極」設於該有機薄膜表面，「下電極」設於該元件區域表面，證據2無論發明說明或圖式均未揭露或教示系爭案之「上電極」「下電極」技術特徵。

證據2未揭露或教示系爭案之「複數個第一溝槽」技術特徵：

系爭案之複數個第一溝槽分別位於上基板之各第一區域中，避免溢膠「向內流」，達成效果是「避免該密封材料溢出該下基板之該切割區域中與溢入該下基板之各該主動區域中，而影響各該有機發光二極體之正常操作」（系爭案之申請專利範圍第14項）。證據2之溝渠（206）設置於蓋板（204）的「邊緣」，避免溢膠「向外流」，第4A圖之溝渠（206）設置於框膠（212）外緣，第7A圖之溝槽（206）設置於框膠（212）外緣與有機電激發光顯示器元件（202）上方，達成效果是「框膠212的分佈不會超出溝槽206而造成溢膠的現象，進而造成後續模組裂片的困難」（證據2之說明書第10頁）。系爭案之複數個第一溝槽與證據2之溝渠的技術手段、達成效果均不同。證據2未揭露或教示系爭案之「複數個第一溝槽」技術特徵。

申請專利範圍第14項具有進步性：

證據2未揭露或教示系爭案之「至少二元件區域」「至少一切割區域」「至少二第一區域」「至少一第二區域」「上電極」「下電極」「複數個第一溝槽」技術特徵。熟習該項技術者由證據2無法輕易完成本項發明內容。因此，申請專利範圍第14項具有進步性。依據「專利審查基準」規定：「獨立項之發明具進步性時，其附屬項當然具進步性」（1-2-27頁參照）。系爭案之申請專利範圍第15至27項直接或間接依附於第14項，包含第14項的所有技術特徵並作進一步限定。申請專利範圍第14項具有進步性，第15至27項當然

亦具有進步性。

原處分違反90年專利法第20條第2項規定：

原處分理由（八）謂：「查證據2所揭示蓋板上係具有溝渠，可使框膠的分佈不會超過溝渠，可避免溢膠的現象。…熟悉該項技術者可藉由證據2所揭示之結構所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第14項具有進步性。」（原處分第8頁第8至29行參照）證據2未揭露或教示系爭案之「至少二元件區域」「至少一切割區域」「至少二第一區域」「至少一第二區域」「上電極」「下電極」技術特徵。證據2之溝渠（206）係避免溢膠「向外流」而設置於蓋板的邊緣（對應於系爭案之「第二區域」），而系爭案之「複數個第一溝槽」係避免溢膠「向內流」而分別位於上基板之「各第一區域中」，二者之技術手段及達成效果均有顯著差異。原處分忽略系爭案與證據2之差異，認定系爭案申請專利範圍第14項不具進步性實屬率斷，違反90年專利法第20條第2項規定。

(5)申請專利範圍第24項：

系爭案之申請專利範圍第24項為：「24.如申請專利範圍第14項之有機發光元件另包含有至少一第二溝槽位於該點膠區域與該主動區域間的該下基板中，且該第二溝槽之深度係小於該下基板之厚度。」

證據2未揭露或教示系爭案之「第二溝槽」技術特徵：

系爭案之第二溝槽設置於位於「點膠區域與主動區域間」的「下基板」中，避免溢膠「向內流」，達成效果是「避免該密封材料溢出該下基板之該切割區域中與溢入該下基板之各該主動區域中，而影響各該有機發光二極體之正常操作」（系爭案之申請專利範圍第14項）。證據2之溝槽結構設置於「蓋板」（對應於系爭案之「上基板」）的「邊緣」，第4A圖之溝渠（206）設置於框膠（212）外緣，第7A圖之溝槽（206）設置於框膠（212）外緣與有機電激發光顯示器元件（202）上方，避免溢膠「向外流」，達成效果是「框膠212的分佈不會超出溝槽206而造成溢膠的現象，進而造成後續模組裂片的困難」（證據2之說明書第10頁）。系爭案之第二溝槽與證據2之溝槽結構的技術手段、達成效果均不同。證據2未揭露或教示系爭案之「第二溝槽」技術特徵。

申請專利範圍第24項具有進步性：

熟習該項技術者由證據2無法輕易完成本項發明內容。因此，申請專利範圍第24項具有進步性。

原處分違反90年專利法第20條第2項規定：

原處分理由（八）謂：「系爭案附屬項第24項該第二溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該下基板中，且該第二溝槽之深度係小於該下基板之厚度，惟此技術特徵可藉由證據2圖7A所揭示，內側的溝渠係位於點膠區域以及有機電激發光顯示器元件之間，即系爭案附屬項24所載技術特徵可為熟悉該項技術者可藉由證據2之結構揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第24項具有進步性。」（原處分第10頁第20至27行參照）如前所述（一（四）），原處分將系爭案申請專利範圍第24項之第二溝槽位於該點膠區域與「該主動區域」間的該下基板中，誤為位於該點膠區域與「該預定區域」間的該下基板中，其認定事實有誤。證據2之溝渠（206）係避免溢膠「向外流」設置於「蓋板」（204）（對應於系爭案之「上基板」）的「邊緣」，而系爭案之「第二溝槽」係避免溢膠「向內流」設置於位於「點膠區域與預定區域間」的「下基板」中，一在上一在下，二者之技術手段及達成效果均有顯著差異。原處分忽略系爭案與證據2之差異，認定系爭案申請專利範圍第24項不具進步性實屬率斷，違反90年專利法第20條第2項規定。

(6)申請專利範圍第25項：

系爭案之申請專利範圍第25項為：「25.如申請專利範圍第14項之有機發光元件另包含有至少一第三溝槽位於該點膠區域與該主動區域間的該透明導電層中，且該第三溝槽之深度係小於該透明導電層之厚度。」

證據2未揭露或教示系爭案之「第三溝槽」技術特徵：

系爭案之第三溝槽設置於位於「點膠區域與預定區域間」的「透明導電層」中，避免溢膠「向內流」，達成效果是「避免該密封材料溢入該下基板之該預定區域中而影響該有機發光二極體之正常操作」（系爭案之申請專利範圍第14項）。證據2之溝槽結構設置於「蓋板」（對應於系爭案之「上基板」）的「邊緣」，第4A圖之溝渠（206）設置於框膠（212）外緣，第7A圖之溝槽（206）設置於框膠（212）外緣與有機電

激發光顯示器元件（202）上方，避免溢膠「向外流」，達成效果是「框膠212的分佈不會超出溝槽206而造成溢膠的現象，進而造成後續模組裂片的困難」（證據2之說明書第10頁）。系爭案之第三溝槽與證據2之溝槽結構的技術手段、達成效果均不同。證據2未揭露或教示系爭案之「第三溝槽」技術特徵。

申請專利範圍第25項具有進步性：

熟習該項技術者由證據2無法輕易完成本項發明內容。因此，申請專利範圍第25項具有進步性。

原處分違反90年專利法第20條第2項規定：

原處分理由（八）謂：「系爭案附屬項第25項該第三溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該下基板中，且該第三溝槽之深度係小於該下基板之厚度，惟此技術特徵可藉由證據2圖7A所揭示，內側的溝渠係位於點膠區域以及有機電激發光顯示器元件之間，即系爭案附屬項25所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由證據2之結構揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第25項具有進步性。」（原處分第10頁第27至34行參照）如前所述（一（五）），原處分將系爭案申請專利範圍第25項之第三溝槽位於該點膠區域與「該主動區域」間的「該透明導電層」中，誤爲位於該點膠區域與「該預定區域」間的「該下基板」中，其認定事實有誤。證據2之溝渠（206）係避免溢膠「向外流」設置於「蓋板」（204）（對應於系爭案之「上基板」）的「邊緣」，而系爭案之「第三溝槽」係避免溢膠「向內流」設置於位於「點膠區域與主動區域間」的「透明導電層」中，一在上一在下，二者之技術手段及達成效果均有顯著差異。原處分忽略系爭案與證據2之差異，認定系爭案申請專利範圍第25項不具進步性實屬率斷，違反90年專利法第20條第2項規定。

(7)系爭案具有進步性：

構造及功效均不相同即具有進步性：

最高行政法院89年判字第1045號判決（附件二）以「本案與引證案之構造及功效均不相同」而肯定被異議案之進步性。

系爭案與證據2之構造及功效均不相同：

茲以下表說明系爭案與證據2之構造及功效差異。

項目	系爭案	證據2
構造	上電極 下電極	未揭露或教示
	至少二元件區域 至少一切割區域 至少二第一區域 至少一第二區域	未揭露或教示
	第一溝槽 設置於上基板相對於 下基板之「點膠區域 與預定區域間」的表 面	溝槽結構設置於「蓋板 」（對應於系爭案之「 上基板」）的「邊緣」
	第二溝槽 設置於位於「點膠區 域與預定區域間」的 「下基板」中	
	第三溝槽設置於位於 「點膠區域與預定區 域間」的「透明導電 層」中	
手段	避免溢膠「向內流」	避免溢膠「向外流」
功效	避免該密封材料溢入 該下基板之該預定區 域中而影響該有機發 光二極體之正常操作	框膠212的分佈不會超 出溝槽206而造成溢膠 的現象，進而造成後續 模組裂片的困難

原行政處分僅以證據2設置於「蓋板」（對應於系爭案之「上基板」）的「邊緣」的溝槽結構，即認定系爭案位於「上基板」之「第一溝槽」與位於「下基板」之「第二溝槽」「第三溝槽」均為可輕易完成，顯屬率斷。

系爭案之美國對應案已核准專利：

被告於民國91年9月5日提出系爭案，申請案號爲00000000。於民國91年11月7日提出美國專利申請，並主張台灣優先權00000000申請案即系爭案。可知美國申請案與系爭案爲同一發明，經查系爭案對應之美國申請案業已核准專利，專利號碼爲US6,825,612B2（附件三）。足證系爭案已經工業先進國家審查具備專利性。

4.原處分違反專利審查基準：

(1)專利審查基準之法律效力：

審查基準之設置目的在於追求公正且效率的專利審查，使審查人員於專利審查程序有標準得以依循執行，申請人與專利工作者有標準得以保障權益。專利審查基準，係專利專責機關所公布，用以規範審查人員進行專利審查的一般、抽象規定，其法律性質屬於行政規則中的裁量基準（行政程序法第159條參照）。有效下達之行政規則，具有拘束訂定機關、其下級機關及屬官之效力（行政程序法第161條參照）。行政機關對於具體案件，基於「行政自我拘束原則」與「平等原則」，若無合法的實質理由即須遵循行政規則所生之行政慣例，因此具有對外效力（行政程序法第161條立法理由參照）。行政法院73年判字第695號判決要旨：「專利審查標準無論程序或實體均應一致，以求公平。」；大院91年訴字第4888號判決揭示：「故專利審查基準，雖係專利主管機關爲協助所屬公務員統一解釋法令、認定事實及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定及裁量基準，但經由行政自我拘束原則及平等原則，已發生對外規範效力，被告於個案審查時，對其是否符合專利權要件之判斷方法或程序，違反專利審查基準所規定者，即屬違法。」；大院92年訴字第628號判決揭示：「『專利審查基準』之規定，如屬對規範之解釋性而具有對外效力者，一旦違背此類行政規則，即可能會影響其對外行爲之效力，換言之，其據以作成之行政處分便有違法之原因。」

(2)經查被告所作原處分多處違反被告所公布之專利審查基準，顯然違法：

違反「判斷進步性以申請專利範圍爲準」：

被告所公布「專利審查基準」規定：「判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載發明，判斷有無專利法第二十條第二項之規定情事，如有則不具進步性，如無始具有進步性。」（1-2-20頁參照）被告審

查系爭專利之申請專利範圍第12、20、21、24、25項，認定事實有誤，原處分判斷前揭項次有無進步性即未依申請專利範圍之請求項所載發明，違反前揭專利審查基準規定，顯有違誤。

違反「逐項審查原則」：

被告所公布「專利審查基準」規定：「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性。」（1-2-20頁參照）原處分對於系爭專利之申請專利範圍第20、21、24、25項認定事實之錯誤，係因直接沿用申請專利範圍第7、8、11、12項之審定理由，而未明察各請求項之差異所致。可見原處分並未就每一請求項個別判斷其進步性，違反前揭專利審查基準規定，顯有違誤。

後見之明：

被告所公布「專利審查基準」規定：「進步性之研判，因審查委員在審查中瞭解其技術內容後，極易對發明之進步性作成偏低之評斷，以致有"後見之明"之情形，故審查時應以熟習該項技術者之觀點，根據申請當時之技術水準，作客觀之判斷。」（1-2-28頁參照）證據2之溝渠（206）係避免溢膠「向外流」而設置於「蓋板」（204）（對應於系爭專利之「上基板」）的「邊緣」，原處分由證據2即認定避免溢膠「向內流」而設置於「點膠區域與預定區域間」或「各該第一區域中」之「上基板」的「第一溝槽」、設置於「該點膠區域與該預定區域間」或「該點膠區域與該主動區域間」之「下基板」的「第二溝槽」、設置於「該點膠區域與該預定區域間」或「該點膠區域與該主動區域間」之「透明導電層」的「第三溝槽」，均爲熟習該項技術者所能輕易完成，無視於溝槽所在之元件差異（上基板、下基板、透明導電層）與位置差異，完全忽略技術手段與達成效果之差異，顯屬後見之明，違反前揭專利審查基準規定，顯有違誤。

未考慮技術領域被告所公布「專利審查基準」規定：「在技術發展空間有限之領域中（in the field of the crowded art），如在技術上有微小的改進，得視爲具有『顯然的進步』」（1-2-21頁參照）。在OLED技術發展空間有限領域，技術上有微小改進得視爲具有「顯然的進步」。更何況系爭案與證據2之技術手段及達成效果均有顯著差異，當然具有進步性。

原處分違反前揭專利審查基準規定，顯有違誤。

5.原處分違反行政程序法規定：

行政程序法第1條揭櫫立法意旨「為使行政遵循公正、公開與民主之程序，確保依法行政之原則，以保障人民權益，提高行政效能，增進人民對行政之信賴」，因此行政程序應公正、公開、透明化。倘行政程序不公正、不公開、不透明，將損及行政決定的正確性，並損及人民權益。原處分違反行政程序法之處詳述於後：

(1)違反說明理由義務：

行政程序法第43條規定：「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」原處分對於系爭案之申請專利範圍第12、20、21、24、25項認定事實有誤，基於錯誤事實認定之審定理由即不成立，違反說明理由義務，即構成理由不備之違法。證據2未揭露或教示系爭專利之申請專利範圍第1項「上電極」「下電極」「第一溝槽」、申請專利範圍第11項「第二溝槽」、申請專利範圍第12項「第三溝槽」、申請專利範圍第14項「至少二元件區域」「至少一切割區域」「至少二第一區域」「至少一第二區域」「上電極」「下電極」「第一溝槽」、申請專利範圍第24項「第二溝槽」、申請專利範圍第25項「第三溝槽」等技術特徵，原處分認定熟習該項技術者由證據2可輕易完成前揭請求項未附實質理由，違反說明理由義務，即構成理由不備之違法。原處分違反說明理由義務，訴願決定竟維持原處分，違反行政程序法規定，自應予撤銷。

(2)未對當事人有利及不利之事項一律注意：

行政程序法第9條規定：「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」原告所提異議答辯書比對系爭案與異議證據之差異，說明系爭案符合新穎性與進步性之理由。原處分既未採納異議答辯書之理由，亦未說明為何異議答辯書不可採，除違反說明理由義務，亦未對當事人有利及不利之情形一律注意，違反行政程序法規定，自無可維持。原處分違反有利及不利之事項一律注意原則，訴願決定竟維持原處分，違反行政程序法規定，自應予撤銷。

6.結論：

綜上所述，訴願決定及原處分違法不當，侵害人民權益，

求爲撤銷訴願決定及原處分，爲有理由，請撤銷訴願決定及原處分。

(二)被告主張之理由：

1.起訴理由二稱原處分違反判斷進步性之基本原則及方式。惟查證據2至4與系爭專利有相同創作目的，已揭露系爭專利所有構件，有相同技術手段，亦同樣具有功效，審定書已詳載證據2至4足資證明系爭專利不具進步性之理由，不再贅述，原處分認事用法並無違誤。

2.起訴理由二稱系爭專利附屬項11、12、24、25原處分未做詳實比對，違反判斷進步性之基本原則及方式。惟系爭專利附屬項11、12、24、25爲獨立項之進一步限制，且僅在於界定溝槽深度等技術特徵，可爲熟悉該項技術者藉由證據2至4所揭示輕易完成，故不具進步性。原處分並無不當，起訴理由不足採。

3.起訴理由及補充起訴理由稱系爭案申請專利範圍第12、20、21、24及25項於原處分之認定與事實有誤。經查原處分理由（六）關於系爭案申請專利範圍第12、20、21項、24項及25項所載確實如原告所稱，該等錯誤實屬被告將系爭案申請專利範圍項次之內容誤繕，如透明導電層誤植爲下基板、複數層電洞注入層誤植爲一電洞注入層、主動區域植爲預定區域，就實質技術而論，前述各項皆爲進一步限定其所依附之請求項所載之技術特徵之附屬項，即回復至原審定公告本申請專利範圍之各項正確之內容，仍不影響原處分認定系爭案各項不具進步性之判斷。

4.起訴理由及補充起訴理由稱原處分不備理由。查原處分理由（六）所載，異議理由稱系爭案申請專利範圍第1項主要技術特徵已見證據2所揭示以及附屬項第2項至第13項技術特徵已見於證據2、3及4所揭示而不具進步性。查證據2所揭示蓋板上係具有溝渠，可使框膠的分佈不會超過溝渠，可避免溢膠的現象。相較系爭案申請專利範圍第1項所揭示之技術特徵該第一溝槽係用來避免該密封材料溢入該下基板之該預定區域中而影響該有機發光二極體之正常操作，熟悉該項技術者可藉由證據2所揭示之結構所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第1項具有進步性。系爭案附屬項第2項該下基板係爲一玻璃基板、一塑膠基板或一金屬基板，惟此技術特徵可藉由證據3所揭示該有機電致發光元件設有玻璃基板，以及證據4所揭示塑膠基板，可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據3玻璃基板或證據4塑膠基板所能思及而輕易完成，難謂

系爭案申請專利範圍第1項具有進步性。系爭案附屬項3項該上基板係包含有一玻璃基板、一玻璃罐(container)或一金屬罐，惟此技術特徵可藉由證據3所揭示該有機電致發光元件設有玻璃基板、ITO電極等以及玻璃密封殼體，以及證據4所揭示玻璃基板，可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據3或證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第3項具有進步性。系爭案附屬項4該下電極係包含有氧化銦錫(indium tin oxide，ITO)或氧化銦鋅(IZO)，用來當作該有機發光二極體之陽極(anode)，惟此技術特徵可藉由證據3所揭示該有機電致發光元件設有玻璃基板、ITO電極等以及玻璃密封殼體，以及證據4所揭示正極材料爲透明導電層，具有發射電洞的功能，其可使用的材料爲銦錫氧化物等，可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據3或證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第4項具有進步性。系爭案附屬項5該上電極係包含有鎂金屬、鋁金屬、鋰金屬或合金材質,用來當作該有機發光二極體之陰極(cathode)，惟此技術特徵可藉由證據4所揭示負極爲金屬電極，具有發射電子的功能，其可使用的材料爲鋁、銦、鎂、鈣或其所形成的合金等，可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第5項具有進步性。系爭案附屬項6該有機薄膜另包含有一電洞傳輸層(hole transport layer，HTL)位於該下電極表面，一發光層(emitting layer，EML)位於該電洞傳輸層表面，以及一電子傳輸層(electron transport layer，ETL)位於該發光層表面，惟此技術特徵可藉由證據3所揭示薄層體包含電洞供給層與電子供給層，以及證據4所揭示基材上有正極，塗佈一層或數層材料於正極上，包括有機發光層、電子/電洞傳遞層，或可增進電子/電洞發射層等，即系爭案附屬項6所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據3或證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第6項具有進步性。系爭案附屬項7另包含有一電洞注入層(hole injection layer，HIL)位於該下電極與該電洞傳輸層之間，惟此技術特徵可藉由證據3所揭示薄層體包含電洞供給層與電子供給層，以及證據4所揭示基材上有正極，塗佈一層或數層材料於正極上，包括有機發光層、電子/電洞傳遞層，或可增進電子/電洞發射層等，即系爭案附屬項7所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可

藉由結合證據2之結構與證據3或證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第7項具有進步性。系爭案附屬項8另包含有一電子注入層(electron injection layer，EIL)位於該電子傳輸層與該上電極之間，惟此技術特徵可藉由證據3所揭示薄層體包含電洞供給層與電子供給層，以及證據4所揭示基材上有正極，塗佈一層或數層材料於正極上，包括有機發光層、電子/電洞傳遞層，或可增進電子/電洞發射層等，即系爭案附屬項8所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據3或證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第8項具有進步性。系爭案附屬項9該密封材料係包含有環氧樹脂(epoxy)，惟此技術特徵可藉由證據4所揭示所使用封裝材料爲環氧樹脂系、矽系封裝材料或各種添加劑的封裝材料，即系爭案附屬項9所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第9項具有進步性。系爭案附屬項10該第一溝槽之深度係小於該上基板之厚度的一半，惟此技術特徵可藉由證據2圖7C所揭示，內側的溝渠係位於點膠區域以及有機電激發光顯示器元件之間，即系爭案附屬項10所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由證據2之結構揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第10項具有進步性。系爭案附屬項11該第二溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該下基板中，且該第二溝槽之深度係小於該下基板之厚度，惟此技術特徵可藉由證據2圖7A所揭示，內側的溝渠係位於點膠區域以及有機電激發光顯示器元件之間，即系爭案附屬項11所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由證據2之結構揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第11項具有進步性。系爭案附屬項12該第三溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的該透明導電層中,且該第三溝槽之深度係小於該透明導電層之厚度，惟此技術特徵可藉由證據2圖7A所揭示，內側的溝渠係位於點膠區域以及有機電激發光顯示器元件之間，即系爭案附屬項12所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由證據2之結構揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第12項具有進步性。系爭案附屬項13該乾燥材料(desiccant)設於該有機發光二極體中，用以避免該有機發光二極體之該有機薄膜發生潮濕的現象，惟此技術特徵可藉由證據2所揭示，面板蓋板進行壓合前，將吸濕劑置於蓋板上凹槽，以及證據3已揭示乾燥物，

即系爭案附屬項13所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由證據2之結構及證據3揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第13項具有進步性。

5.原處分理由（七）所載，異議理由稱系爭案申請專利範圍第14項主要技術特徵已見證據2所揭示而不具新穎性。查系爭案申請專利範圍第14項技術特徵爲一種有機發光元件，該有機發光元件係包含有至少二有機發光二極體(organic light emitting diode，OLED)，該有機發光元件包含有：一下基板，該下基板表面包含有至少二元件區域，至少一切割區域位於兩相鄰該元件區域之間，且各該元件區域均包含有一下電極設於該元件區域表面，一有機薄膜設於該元件區域之一主動區域上，以及一上電極設於該有機薄膜表面；一上基板，平行地設於該下基板之上，且該上基板相對於該下基板的表面包含有至少二第一區域相對應於該下基板之該等元件區域，至少一第二區域相對應於該下基板之該切割區域，以及複數個第一溝槽(ditch)分別位於該上基板之各該第一區域中，以及一密封材料(sealing material)位於該上基板與該下基板間之各該主動區域外之一點膠(spot glue)區域上用來黏結該上基板與該下基板；其中該等第一溝槽係用來避免該密封材料溢出該下基板之該切割區域中與溢入該下基板之各該主動區域中,而影響各該有機發光二極體之正常操作。相較證據2（參閱圖7A）所揭示有機電激發光顯示器元件結構，其中包括一面板、一有機電激發光顯示器元件、一框膠以及一蓋板。有機電激發光顯示器元件配置於面板上，蓋板配置於有機電激發光顯示器元件上並藉由框膠與面板黏貼，而框膠配置於面板與蓋板之間，且分佈於有機電激發光顯示器元件的周圍。其中，蓋板的邊緣上具有至少一溝渠結構，用以限定框膠圖佈的範圍。系爭案申請專利範圍第14項所揭示技術特徵該具有該下基板包含有一下電極設於該下基板表面，一有機薄膜設於該下電極之一預定區域表面，一上電極設於該有機薄膜表面，以及一點膠(spot glue)區域設於該預定區域外之該下基板表面，不同於證據2所揭示蓋板配置於有機電激發光顯示器元件上並藉由框膠與面板黏貼，而框膠配置於面板與蓋板之間，且分佈於有機電激發光顯示器元件的周圍，其中，蓋板的邊緣上具有至少一溝渠結構，用以限定框膠圖佈的範圍，故系爭案申請專利範圍第14項具新穎性。

6.原處分理由（八）所載，異議理由稱系爭案申請專利範圍

第14項主要技術特徵已見證據2所揭示以及第15項至第27項技術特徵已見於證據2、3及4所揭示而不具進步性。查證據2所揭示蓋板上係具有溝渠，可使框膠的分佈不會超過溝渠，可避免溢膠的現象。相較系爭案申請專利範圍第14項所揭示之技術特徵該有機發光元件係包含有至少二有機發光二極體(organic light emitting diode，OLED)，該有機發光元件包含有：一下基板，該下基板表面包含有至少二元件區域，至少一切割區域位於兩相鄰該元件區域之間，且各該元件區域均包含有一下電極設於該元件區域表面，一有機薄膜設於該元件區域之一主動區域上，以及一上電極設於該有機薄膜表面；一上基板，平行地設於該下基板之上，且該上基板相對於該下基板的表面包含有至少二第一區域相對應於該下基板之該等元件區域，至少一第二區域相對應於該下基板之該切割區域，以及複數個第一溝槽(ditch)分別位於該上基板之各該第一區域中，以及一密封材料(sealing material)位於該上基板與該下基板間之各該主動區域外之一點膠(spot glue)區域上用來黏結該上基板與該下基板；其中第一溝槽係用來避免該密封材料溢入該下基板之該預定區域中而影響該有機發光二極體之正常操作，熟悉該項技術者可藉由證據2所揭示之結構所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第14項具有進步性。系爭案附屬項15該下基板係爲一玻璃基板、一塑膠基板或一金屬基板，惟此技術特徵可藉由證據3所揭示該有機電致發光元件設有玻璃基板，以及證據4所揭示塑膠基板，可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據3玻璃基板或證據4塑膠基板所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第15項具有進步性。系爭案附屬項16該上基板係包含有一玻璃基板、一玻璃罐(container)或一金屬罐，惟此技術特徵可藉由證據3所揭示該有機電致發光元件設有玻璃基板、ITO電極等以及玻璃密封殼體，以及證據4所揭示玻璃基板，可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據3或證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第16項具有進步性。系爭案附屬項17該下電極係包含有氧化銦錫(indium tin oxide，ITO)或氧化銦鋅(IZO)，用來當作該有機發光二極體之陽極(anode)，惟此技術特徵可藉由證據3所揭示該有機電致發光元件設有玻璃基板、ITO電極等以及玻璃密封殼體，以及證據4所揭示正極材料爲透明導電層，具有發射電洞的功能，其可使用的材料爲銦錫氧化

物等，可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據3或證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第17項具有進步性。系爭案附屬項18該上電極係包含有鎂金屬、鋁金屬、鋰金屬或合金材質，用來當作該有機發光二極體之陰極(cathode)，惟此技術特徵可藉由證據4所揭示負極爲金屬電極，具有發射電子的功能，其可使用的材料爲鋁、鋇、鎂、鈣或其所形成的合金等，可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第18項具有進步性。系爭案附屬項19該有機薄膜另包含有一電洞傳輸層(hole transport layer，HTL)位於該下電極表面，一發光層(emitting layer，EML)位於該電洞傳輸層表面，以及一電子傳輸層(electron transport layer，ETL)位於該發光層表面，惟此技術特徵可藉由證據3所揭示薄層體包含電洞供給層與電子供給層，以及證據4所揭示基材上有正極，塗佈一層或數層材料於正極上，包括有機發光層、電子/電洞傳遞層，或可增進電子/電洞發射層等，即系爭案附屬項19所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據3或證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第19項具有進步性。系爭案附屬項20另包含有複數層電洞注入層(hole injection layer，HIL)位於該下電極與該電洞傳輸層之間，惟此技術特徵可藉由證據3所揭示薄層體包含電洞供給層與電子供給層，以及證據4所揭示基材上有正極，塗佈一層或數層材料於正極上，包括有機發光層、電子/電洞傳遞層，或可增進電子/電洞發射層等，即系爭案附屬項20所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據3或證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第20項具有進步性。系爭案附屬項21另包含有複數層電子注入層(electron injection layer，EIL)位於該電子傳輸層與該上電極之間，惟此技術特徵可藉由證據3所揭示薄層體包含電洞供給層與電子供給層，以及證據4所揭示基材上有正極，塗佈一層或數層材料於正極上，包括有機發光層、電子/電洞傳遞層，或可增進電子/電洞發射層等，即系爭案附屬項21所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據3或證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第21項具有進步性。系爭案附屬項22該密封材料係包含有環氧樹脂(epoxy)，惟此技術特徵可藉由證據4所揭示所使用封裝材料爲環

氧樹脂系、矽系封裝材料或各種添加劑的封裝材料，即系爭案附屬項22所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由結合證據2之結構與證據4揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第22項具有進步性。系爭案附屬項23該第一溝槽之深度係小於該上基板之厚度的一半，惟此技術特徵可藉由證據2圖7C所揭示，內側的溝渠係位於點膠區域以及有機電激發光顯示器元件之間，即系爭案附屬項23所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由證據2之結構揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第23項具有進步性。系爭案附屬項24該第二溝槽位於該點膠區域與該主動區域間的該下基板中，且該第二溝槽之深度係小於該下基板之厚度，惟此技術特徵可藉由證據2圖7A 所揭示，內側的溝渠係位於點膠區域以及有機電激發光顯示器元件之間，即系爭案附屬項24所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由證據2之結構揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第24項具有進步性。系爭案附屬項25該第三溝槽位於該點膠區域與該主動區域間的該透明導電層中，且該第三溝槽之深度係小於該該透明導電層之厚度，惟此技術特徵可藉由證據2圖7A所揭示，內側的溝渠係位於點膠區域以及有機電激發光顯示器元件之間，即系爭案附屬項25所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由證據2之結構揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第25項具有進步性。系爭案附屬項26該切割區域之寬度係大於各該第一溝槽之寬度的兩倍，惟此技術特徵可爲熟悉該項技術者所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第26項具有進步性。系爭案附屬項27該乾燥材料(desiccant)設於該有機發光二極體中，用以避免該有機發光二極體之該有機薄膜發生潮濕的現象，惟此技術特徵可藉由證據2所揭示，面板蓋板進行壓合前，將吸濕劑置於蓋板上凹槽，以及證據3已揭示乾燥物，即系爭案附屬項27所載技術特徵可爲熟悉該項技術者可藉由證據2之結構及證據3揭示所能思及而輕易完成，難謂系爭案申請專利範圍第27項具有進步性。原處分認事用法並無違誤，起訴理由及補充起訴理由不足採。

7.起訴理由及補充起訴理由稱系爭案具有顯然的進步應具有進步性。查被告審查基準1-2-21頁所載「顯然的進步」係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。就系爭案所達到之功效相較於證2、3所揭示是相同，而原告指稱系爭案具有功效上之

增進而具有進步性，顯屬原告對表現於功效上錯誤之解讀。

綜上所述，被告原處分並無違法，請駁回原告之訴。

(三)參加人未到庭或以書狀提出意見或陳述。

理　由

一、本件被告代表人原爲蔡練生，嗣由王美花接任，其聲請承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。

二、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用且無違背新穎性情事者，固得依系爭專利核准審定時專利法第19條及第20條第1 項之規定申請取得發明專利。惟其「發明係運用申請前既有之技術或知識，而爲熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復爲同法第20條第2 項所明定。

三、次按，專利異議案係採當事人進行主義，此觀行爲時專利法第41條規定自明。原處分機關爲異議審查時，自僅能以異議人所提起之異議範圍予以審查。而判斷原處分機關是否已依當事人異議事項予以審查，仍須依其異議理由書所載之具體事實及理由加以認定。按現行專利法第43條第2 項規定：「經審查不予專利者，審定書應備具理由。」又行政程序法第96 條 第1 項規定：「行政處分以書面爲之者，應記載下列事項：・・・二主旨、事實、理由及其法令依據。・・・」是知具備行政處分性質之核駁審定書應記載「理由」，而此所謂記載不予專利之理由，自係指記載認定事實無誤之理由而言，否則即因未符上揭法律規定而生理由不備或矛盾之違法。

四、查本件原告前於91年9 月5 日以系爭專利向被告申請准予專利，經被告編爲第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項之規定，不符發明專利要件，對之提起異議。案經被告機關審查，於95年8 月15日以系爭處分爲「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟之事實，有參加人專利異議理由書、原告專利異議答辯書、系爭專利公告、系爭處分及訴願書等，各附原處分卷足稽。兩造主張之事實、理由及陳述，有如上述整理，雙方主要爭執在：系爭處分有無事實與理由矛盾之違法情事及系爭專利是否有違反核准審定時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項之規定？

五、經查：

(一)原告起訴主張被告系爭處分對於系爭專利範圍第12、20、21

、24及第25項認定事實有誤，有漏未審查之情事等語。被告則於本院96年1 月8 日第一次準備程序中陳明系爭處分確有如原告所述對於系爭專利範圍第12、20、21、24及第25項誤繕之情形，請求在本件訴訟中更正此項誤繕等語置辯。

(二)惟按「行政處分如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，處分機關得隨時或依申請更正之。」行政程序法第101 條第1 項定有明文。是知系爭處分之更正，依法限於「誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者」始足當之。然查：

1.系爭申請專利範圍第12項載爲：「12. 如申請專利範圍第1 項之有機發光二極體另包含有至少一第三溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的『該透明導電層中』，且該第三溝槽之深度係小於『該透明導電層』之厚度。」而相對應之系爭處分理由(六)則載爲：「系爭案附屬項第12項該第三溝槽『位於該點膠區域與該預定區域間的『該下基板中』，且該第三溝槽之深度係小於『該下基板』之厚度」（見原處分第6 頁第34至36行）。

2.系爭案之申請專利範圍第20項爲：「20. 如申請專利範圍第19項之有機發光元件另包含『有複數層電洞注入層』（holeinjection layer, HIL），且各該電洞注入層係分別位於各該下電極與各該電洞傳輸層之間。」而相對應之系爭處分理由(八)則載爲：「系爭案附屬項第20項另包含『有一電洞注入層（hole injection layer，HIL ）位於該下電極與該電洞傳輸層之間」（見原處分第9 頁第29至31行）。

3.系爭案之申請專利範圍第21項載爲：「21. 如申請專利範圍第19項之有機發光元件另包含『有複數層電子注入層』（electron injection layer, EIL ），且各該電子注入層係分別位於各該電子傳輸層與各該上電極之間。」而相對應之系爭處分理由(八)則載爲：「系爭案附屬項第21項另包含『有一電子注入層』（electron injection layer，EIL ）位於該電子傳輸層與該上電極之間」（見原處分第9 頁第38行至第10頁第1 行）。

4.系爭案之申請專利範圍第24項載爲：「24. 如申請專利範圍第14項之有機發光元件另包含有至少一第二溝槽位於該點膠區域與『該主動區域間』的該下基板中，且該第二溝槽之深度係小於該下基板之厚度。」而相對應之系爭處分理由(八)則載爲：「系爭案附屬項第24項該第二溝槽位於該點膠區域與『該預定區域間』的該下基板中，且該第二溝槽之深度係小於該下基板之厚度」（見原處分第10頁第20

至21行）。

5.系爭案之申請專利範圍第25項載爲：「25. 如申請專利範圍第14項之有機發光元件另包含有至少一第三溝槽位於該點膠區域與該主動區域間的『該透明導電層中』，且該第三溝槽之深度係小於『該透明導電層』之厚度。」而相對應之系爭處分理由(八)則載爲：「系爭案附屬項第25項該第三溝槽位於該點膠區域與該預定區域間的『該下基板中』，且該第三溝槽之深度係小於『該下基板』之厚度」（見原處分第10頁第27至28行）。

6.基上，系爭專利範圍之實際位置與系爭處分所載述之位置顯然不同，而此種差異，數量已達5 項之多，核認該等區域位置，又屬系爭專利範圍之重要事項，其縱有誤繕情形，因已經影響系爭專利第12、20、21、24及第25項專利範圍之認定，自不能與僅生單純文字誤繕而得隨時更正者相比擬。被告在本件行政訴訟中所爲更正，核與上開行政程序法第101 條第1 項所定可以更正之情形未符，不能准許，應認系爭處分認定事實有誤，致生漏未就正確的系爭專利內容審查之情事，依上開規定與說明，亦有事實與理由矛盾之違法，自無由維持，應發回原處分機關更爲審認，以爲適法之處分。

7.被告主張起訴理由及補充起訴理由稱系爭案申請專利範圍第12、20、21、24及25項於原處分之認定與事實有誤，仍不影響原處分認定系爭案各項不具進步性之判斷等云，容有誤解前開行政程序法第101 條第1 項之規定，無法採取。

六、綜上，原告主張系爭處分有關系爭專利範圍第12、20、21、24及第25項之事實認定有誤，足以採信。被告迄本件訴訟中始主張爲誤繕，應予更正乙節，因與行政程序法第101 條第1 項之規定未合而無法採取，則系爭處分認定事實與系爭專利內容未符，核屬事實與理由矛盾之違法，無法維持。訴願決定未予糾正，仍予維持，即有未合，均應予以撤銷，發回原處分機關另爲適法之處分，以昭折服。

七、至系爭處分既有如上述之瑕疵而無由維持，則有關系爭專利是否有違反核准審定時專利法第20條第1 項第1 款及第2項之規定部分，即有待被告機關於發回後重新審查，本院就此部分尚毋庸審究；又本件判決基礎已經明確，兩造其餘主張或陳述，與判決結果無影響，不再一一論述，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴爲有理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　97　　年　　3　　月　　6　　日

臺北高等行政法院第六庭

審判長法　官　林　文　舟

法　官　許　瑞　助

法　官　陳　鴻　斌

上爲正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中　　華　　民　　國　　97　　年　　3　　月　　10　　日

書記官　陳　清　容